

MOD법에 의한 Sr modified PbTiO₃ 박막 제조 및 Tunable microwave device 응용 특성 연구

Sr modified PbTiO₃ thin films for tunable microwave device application

강동현¹, 조수철¹, 차춘주¹, 조봉희^{2*}

(D. H. Kang¹, S. C. Cho¹, H. J. Cha¹, B. H. Cho²)

Abstract

(Pb_{1-x}Sr_x)TiO₃ ($0.6 \leq x \leq 0.8$) thin films were prepared by the MOD method for tunable microwave device application and their characteristics were investigated as a function of Sr content(x) and applied field. Thin films showed a homogeneous microstructure and the tetragonality(c/a) was slightly decreased with increasing Sr content. With increasing Sr content, Curie temperature of the thin films showed a decreasing tendency. For the PST thin films, the dielectric constant at room temperature, T_c, and tan δ were 750~1900, -70°C~-30°C and 0.025~0.04, respectively.

Key Words : sol-gel, tunable microwave device, dielectric property, tunability

1. 서 론^[1]

강유전성 물질(ferroelectric materials)은 우수한 유전, 압전, 광학적인 특성들로 인해 많은 전자 소자 및 광학 소자에 응용되고 있다. 또한 최근에는 강유전 물질의 고유 특성을 이용한 비휘발성 메모리 소자와 microwave 소자의 재료로서 각광받고 있다. 특히 microwave 소자로 이용되기 위해서는 높은 tunability($\epsilon_{\max} - \epsilon_{\min} / \epsilon_{\max}$), 낮은 유전 손실, 높은 유전 상수 등이 요구된다.[1]

페로브스카이트 구조를 갖고 있는 BaTiO₃ (BT),

PbTiO₃ (PT), PbZrO₃ (PZ), Pb_{1-x}Zr_xTiO₃(PZT), SrTiO₃ (ST), Pb_{1-x}LaxTiO₃ (PLT) 등의 물질들이 이러한 응용에 사용되고 있으나, 이번 연구에서 다루는 (Pb_{1-x}Sr_x)TiO₃ (PST)는 Ikeda[2]가 보고한 PbTiO₃-SrTiO₃-SrZrO₃-PbZrO₃ phase diagram을 근거로, 이 phase diagram 상에서 PbTiO₃-SrTiO₃ binary component를 선택하였다. (Pb_{1-x}Sr_x)TiO₃는 상온에서 Sr의 함량에 따라 tetragonal과 cubic 2 가지의 구조를 가질 수 있다. (Pb_{1-x}Sr_x)TiO₃는 $0 \leq x \leq 0.67$ 범위에서 tetragonal 구조를, $0.67 \leq x \leq 1$ 일 때 cubic 구조를 갖는다.[3][4]

박막 제조 방법에는 r.f.magnetron sputtering, laser ablation, pulsed laser deposition(PLD), metal organic decomposition(MOD), metal

* 수원대학교 전자재료공학과, ** 전기공학과
(경기도 수원시 수원 P.O box 77)

Fax : 031-220-2699

E-mail : dhkang@mail.suwon.ac.kr

organic chemical vapor deposition (MOCVD), sol-gel processing 등이 사용된다.[1][3][4]

이중 MOD법에 의한 박막의 제조는 화학적 조성 제어가 용이하고, 균일한 막의 제조가 가능하며, 대규모 면적의 제작이 가능하고, 고가의 장비가 필요하지 않은 장점이 있다.

본 연구에서는 MOD법으로 $(\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x)\text{TiO}_3$ ($x=0.6\sim0.8$) 박막을 제조하여, Sr 조성에 따른 결정성과 고주파응용 전기적 특성을 조사하였다.

2. 실험

MOD법을 사용하여 PST 박막을 제조하였다. 출발 물질로는 lead acetate, strontium acetate, titanium isopropoxide를 사용하였고, 2-methoxy-ethanol (2-MOE), distillation water (DI-water), propylene glycol(PG)이 용매로 사용되었으며, titanium isopropoxide를 안정화시키기 위하여 acetylacetone (AcAc)을 착제로 사용하였다. Pb-Sr 전구체는 각각의 물수대로 청량하여 DI-water와 PG를 혼합한 용매에 첨가해 80°C에서 24시간 교반하여 제조하였다. Ti 전구체는 질소분위기의 glove box에서 청량하여 용매인 2-MOE에 첨가한 후, 착제인 AcAc를 첨가하여 3시간 교반하였다. 이 Ti 전구체를, 먼저 제조한 Pb-Sr 전구체와 혼합하여 0.2M의 코팅 용액을 제조하였고, 24시간 교반 후, 1일간 숙성시켜 코팅 용액을 제조하여 사용하였다.

이렇게 제조된 최종 코팅 용액을 DI-water, acetone, isopropylalcohol (IPA) 순으로 각 5분간 초음파 세척 후, 고순도 N₂ gun 및 400°C hot plate에서 10분간 건조시켜 잔류 수분을 완전히 제거한 Pt(111)/Ti/SiO₂/Si 기판에 0.2μm syringe filter로 거른 후, spin coating 법으로 4000rpm에서 35초간 spinning하여 박막을 증착하였다.

Spin 코팅 된 박막은 120°C의 hot plate 위에서 1분간 건조시켜 수분과 약간의 유기물을 제거시킨 후, 중간 열처리 없이 마지막 열처리 온도와 같은 온도로 열처리하는 multi 코팅을 행하였다.

원하는 두께의 박막(0.3μm)을 얻기 위해 코팅 과정을 반복하였으며, 최종 박막의 결정화를 위하여 700°C에서 20분간 공기 중에서 RTA (MILA-3000-P-N, ULVAC)를 이용하여 최종 열처리하였다.

전기적 특성을 측정하기 위해서 박막 시편 위에 shadow mask를 부착한 후, sputtering으로 Pt 상

부 전극을 증착 하였고, 광학 현미경으로 측정한 전극의 직경은 0.5mm였다.

제조된 박막의 페로브스카이트 상의 생성을 확인하기 위하여 X-ray diffractometer(D/MAX 2C, Rigaku)를 사용하여 분석하였고, 유전 특성과 C-V 특성은 Impedance analyzer(HP 4294A)을 사용하여 측정하였으며, 박막의 이력 곡선은 PC에 연결된 Precision Pro를 사용하여 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

그림 1에서는 증착된 박막의 결정 구조를 알아보기 위하여 XRD 분석을 행한 결과를 보여준다. 순수한 PT의 tetragonality (c/a)가 1.031이고, PST(40/60), (30/70), (20/80)의 경우, 0.012~1.006으로 약간의 감소경향을 보여 Sr 치환양이 증가함에 따라 박막의 결정구조가 cubic에 가까워짐을 확인 할 수 있었다.

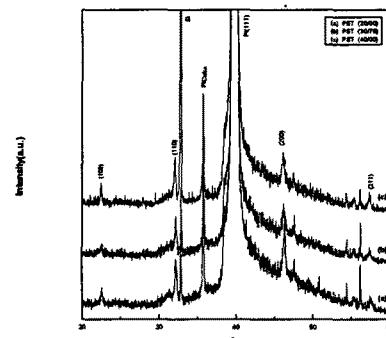


그림 1. Sr 조성비에 따른 $\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$ ($0.6 \leq x \leq 0.8$) 박막의 XRD 회절 분석
a) $x=0.8$, b) $x=0.7$, c) $x=0.6$

Fig. 1. X-ray diffraction patterns of $\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$ ($0.6 \leq x \leq 0.8$) thin films as a function of Sr content.
a) $x=0.8$, b) $x=0.7$, c) $x=0.6$

그림 2는 각 조성 변화에 따른 상온에서의 유전 특성을 측정한 그림이다. 이 결과에서는 상온에서 PST(40/60) 조성이 최대 유전 상수를 나타내었는데, 이는 Sr 첨가로 인한 Tc 상온 이동 경향과 연관된 것으로 사료된다. 이때 $\epsilon r=1885$, $\tan \delta=0.04$ 의 값을 나타내었다.

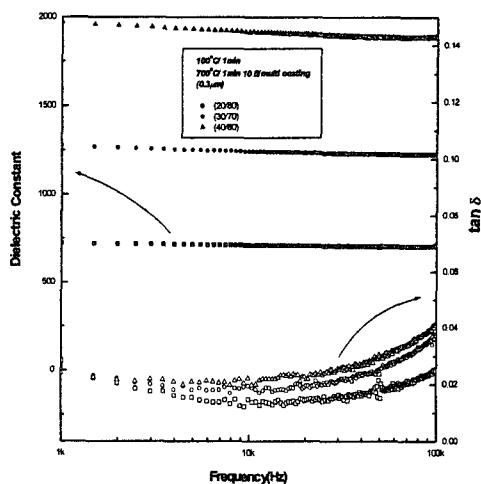


그림 2. $\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$ 조성의 유전 상수 및 유전 손실의 주파수 의존도

Fig. 2. Frequency dependence of dielectric constant and dielectric loss of $\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$

주파수 100kHz에서, electric field($\pm 160\text{kV/cm}$)가 인가되었을 때의 조성별 상온 tunability를 측정한 결과, $\text{Sr} = 0.6$ 에서 70% 정도의 높은 값을 보였고 Sr 증가에 따라 감소하는 경향을 나타냈으며, 이때, Tunability는 $((\epsilon_{\max} - \epsilon_{\min}) / \epsilon_{\max}) * 100$ 으로 표현된다.

4. 결 론

- 1) MOD법을 사용하여 $(\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x)\text{TiO}_3$ 의 박막을 제조하였고, 순수 PT와 PST($0.6 \leq x \leq 0.8$) 조성에서 Sr 침가에 따른 tetragonal에서 cubic으로의 결정 구조 변화와 T_c 의 이동을 확인하였다.
- 2) 제조된 $(\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x)\text{TiO}_3$ 박막의 유전 상수는 Sr 조성의 증가에 따라 증가하였고, PST(40/60)에서 최대 값 ($\epsilon_r = 1885$, $\tan \delta = 0.04$)을 나타내었다.
- 3) Tunable device 용·용을 위한 특성으로, electric field를 인계하고, 그에 따른 유전 상수로 계산한 $(\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x)\text{TiO}_3$ ($0.6 \leq x \leq 0.8$)은 70~40%의 tunability를 나타내었다.

참 고 문 헌

- [1] Dong Li, Munirpallam A. Subramanian, "The influence of Mg doping on the materials properties of $\text{Ba}_{1-x}\text{Sr}_x\text{TiO}_3$ thin films for tunable device applications", Thin Solid Films 374, 34-41, (2000)

- [2] T. Ikeda, J. Phys. Soc. Japan., 14. 1290 (1959)

- [3] K. Iijima, Y. Tomita, R. Takayama, I. Ueda, "Preparation of c-axis oriented PbTiO_3 thin films and their crystallographic, dielectric, and pyroelectric properties", J. Appl. Phys., 60[1], 361-367 (1986)

- [4] D H. Kang, J. H. Kim, J. H. Park K. H. Yoon, "Characteristics of $(\text{Pb}_{1-x}\text{Sr}_x)\text{TiO}_3$ thin films prepared by a chemical solution processing", Mat. Res. Bull. 36, 265-276 (2001)